

УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ, ОПУБЛИКОВАННЫХ В ЖУРНАЛЕ "НАНО- И МИКРОСИСТЕМНАЯ ТЕХНИКА" В 2016 г.

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ

Васильев В. Ю. Тренды развития технологий и производства компонентов и узлов микросистемной техники № 7

НАНОТЕХНОЛОГИИ И ЗОНДОВАЯ МИКРОСКОПИЯ

Булярский С. В., Булярская С. А., Павлов А. А. Термодинамика легирования азотом углеродных нанотрубок № 2

Воробьева А. И., Шулицкий Б. Г., Лабунов В. А., Кашко И. А., Гирель К. В. Массивы углеродных нанотрубок, синтезированные в шаблоне из тонкого пористого оксида алюминия № 1

Глушков Г. И., Тучин А. В., Битюцкая Л. А., Лямичев А. В., Бор-монтов Е. Н. Управление спиновой поляризацией электронов электрическим полем в одностенных ультракоротких углеродных нанотрубках (0, 9) № 9

Залуцкая А. А., Савинский Н. Г., Проказников А. В. Селективное резонансное поглощение электромагнитного излучения наноструктурированными системами № 3

Карташев В. А., Карташев В. В. Изображение нанорельефа при интерпретации измерений методом имитационного моделирования № 3

Ларионов Ю. В. Вариация изображения выступа в ходе его многократного сканирования в низковольтном РЭМ . . . № 11

- Ларионов Ю. В. Зависимость контаминации рельефной структуры от режима сканирования РЭМ № 8
- Леонтьев В. Л., Булярский С. В., Павлов А. А. Резонансные дельтаторы и антенны на основе углеродных нанотрубок, упруго закрепленных на обоих концах № 10
- Пронин И. А., Якушова Н. Д., Карманов А. А., Кононова И. Е., Аверин И. А., Мошников В. А. Особенности золь-гель фрактальных нанообъектов, полученных при дополнительной операции закалки золь ниже температуры замерзания № 6

МОДЕЛИРОВАНИЕ И КОНСТРУИРОВАНИЕ МНСТ

- Блум К. Е., Остертак Д. И. Расчет емкости гребенчатого переменного конденсатора для электростатического вибрационного генератора энергии с учетом краевых эффектов № 7
- Голиков А. В., Панкратов В. М., Панкратова Е. В. Тепловые процессы в бухте волоконно-оптического гироскопа на основе микроструктурированного оптоволокна с углеродными нанотрубками № 10
- Деспотули А. Л., Андреева А. В. Эффективное электростатическое поле в структурно-динамическом подходе наноионики № 1
- Каленов В. Е., Корляков А. В., Кротов С. В. Создание автоколебательного режима работы в микромеханических системах на основе емкостного преобразователя № 5
- Мустафаев М. Г., Мустафаева Д. Г. Моделирование и алгоритмизация неравновесных процессов при создании микроэлектронных приборных структур № 6
- Нидеккер Л. Г. Маршрут разработки библиотеки стандартных элементов № 10
- Парфенов Н. М., Чемоданов В. Б. Особенности физико-технологических свойств структуры кремний — диоксид кремния № 12
- Сироткин В. В. Моделирование массопереноса жидкости под действием поверхностных акустических волн через микроканал с пористой перегородкой № 9
- Старых А. А. Метод синтеза запоминающих элементов самосинхронных схем № 3
- Суханов А. В., Иванов А. В. Использование радиохарвестера для создания миниатюрного источника питания сенсорного узла № 9
- Чернов А. С., Самородов А. Л., Хабаров С. П., Гридчин В. А. Фотоувствительный элемент для сенсора давления с оптической пространственной модуляцией № 7
- Шукевич Я. И., Баркалин В. В., Таратын И. А., Реутская О. Г. Моделирование динамики работы СВЧ МЭМС-переключателя № 11

МАТЕРИАЛОВЕДЧЕСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МНСТ

- Абдуллаев Д. А., Воротилов К. А., Зубкова Е. Н., Серегин Д. С., Сигов А. С. Реактивно-ионное травление пленок цирконата-титаната свинца № 12
- Амеличев В. В., Беляков П. А., Васильев Д. В., Жуков Д. А., Казаков Ю. В., Костюк Д. В., Куриянова М. А., Орлов Е. П., Касаткин С. И., Крикунов А. И., Резнев А. А. Исследование магниторезистивных наноструктур с гигантским магниторезистивным эффектом № 9
- Барулина М. А., Панкратов В. М. Аналитическое решение плоской нестационарной задачи теплопроводности для фотонно-кристаллического волокна с воздушным сердечником № 11
- Васильев В. Ю. Сверхтонкие пленки металлов платиновой группы для применения в нано- и микротехнологиях № 7
- Данилина Т. И., Чистоедова И. А., Попов А. А. Формирование микрорельефа и исследование его влияния на коэффициент оптического вывода светодиода на основе GaN № 11
- Евстафьева М. В., Редькин А. Н., Якимов Е. Е. Сравнение сенсорных характеристик массивов наностержней и пленок оксида цинка при облучении ультрафиолетовым светом № 12
- Игнатов И. И., Мосин О. В. Исследование структурно-функциональных свойств фуллеренсодержащего минерала шун-

- гита и микрокристаллического алюмосиликата цеолита методами элементного анализа, ПЭМ, ИК и ДНЭС-спектроскопии № 6
- Исмаилов А. М., Степуренко А. А., Шаниев И. М., Гумметов А. Э., Алиев И. Ш. Динамические вольт-амперные характеристики висцеров теллура № 9
- Корляков А. В., Лучинин В. В., Хмельницкий И. К., Бройко А. П., Верещагина Л. О., Каленов В. Е., Крот А. И., Рыжкова А. В. Актуаторы на основе ионных полимер-металлических композитов № 5
- Красников Г. Я., Зайцев Н. А., Дайнеко А. В. Физико-технологические особенности формирования сегнетоэлектрической пленки для ячейки запоминающих устройств № 8
- Крутов В. В., Сигов А. С., Шука А. А. Создание микро- и нанодоменных структур в сегнетоэлектриках с использованием интерферирующего гиперзвука № 1
- Лучинин В. В. Технологии превосходства. Карбид кремния. Научно-технологический статус ЛЭТИ № 5
- Макеев М. О., Мешков С. А., Иванов Ю. А. Исследования коэффициентов диффузии Al и Si в AlAs/GaAs резонансно-туннельных гетероструктурах № 8
- Мальцев П. П., Редькин С. В., Глинский И. А., Побойкина Н. В., Духновский М. П., Федоров Ю. Ю., Смирнова А. К., Куликов Е. Н., Щербаков С. В., Леонтьев И. А., Кудряшов О. Ю., Скринниченко А. С. Теплоотводы на поликристаллическом алмазе для мощных СВЧ монолитных интегральных схем № 4
- Мартиневич В. А., Хорунжий И. А., Русецкий М. С., Казюнич Н. М. Теплоотвод на основе алмаза со встроенным датчиком температуры № 4
- Мефтахутдинов Р. М. Электронные и оптические свойства силициновых sp^2 -наноаллотропов № 1
- Мустафаев Г. А., Мустафаева Д. Г., Мустафаев М. Г. Технологические особенности получения соединений халькогенидов элементов первой группы и тонких пленок на их основе заданного состава № 8
- Павлов В. Ю., Павлов А. Ю. Технологии формирования сплавных и несплавных омических контактов к гетероструктурам на основе GaN. Обзор № 10
- Пронин И. А., Якушова Н. Д., Карманов А. А., Аверин И. А., Мошников В. А. Модель сборки наноконструктивных и иерархических наноструктур в золь-гель-процессах № 8
- Пучнин К. В., Рыбачек Е. Н., Кузнецов Е. В., Кузнецов А. Е. Формирование и селективное травление самособирающихся гидрофобных пленок на поверхности SiO_2 и Ta_2O_5 № 9
- Рембеза С. И., Кошелева Н. Н., Свистова Т. В., Рембеза Е. С., Аганов Б. Л., Плотнокова Е. Ю., Белоусов С. А., Носов А. А. Электрофизические свойства пленок $(SnO_2)_x(ZnO)_{1-x}$ ($x = 0...0,5$) для прозрачной электроники № 11
- Рискин Д. Д., Жукова С. А., Обижаев Д. Ю., Турков В. Е. Измерение прочностных свойств адгезионных соединений, полученных методом термокомпрессионного срашивания пластин при изготовлении МЭМС № 3
- Рубан О. А. Исследование поляризации в гетероструктурах с квантовой ямой AlGaIn/GaN методом вольт-фарадных характеристик № 11
- Самойлович М. И., Белянин А. Ф., Ринкевич А. Б., Бовтун В., Кемна М., Нужный Д., Савинов М. Строеие, магнитные и диэлектрические свойства наноконструктивных: опаловые матрицы — ванадаты редкоземельных элементов № 2
- Сауров А. Н., Булярский С. В., Кондратьев П. К., Скворцов А. А., Павлов А. А., Милованов Р. А., Кицюк Е. П. Конструкция и технология изготовления тестовых кристаллов с композитными проводниками на основе углеродных нанотрубок и металлов № 10
- Слаповский Д. Н., Павлов А. Ю., Бугаев А. С., Мальцев П. П., Хабибуллин Р. А., Пономарев Д. С. Низкотемпературная технология формирования омических контактов к гетероструктурам, содержащим In, Al, Ga и As № 8
- Смолин В. К. Пористый кремний: современное состояние и перспективы развития № 6

- Тарасов С. А., Михайлов И. И., Стенанов Е. М., Вылегжанин Д. В., Гуревич М. О., Козлов Л. И., Корнеева А. В., Тадтаев П. О., Соломонов А. В. Люминесцентные свойства структур, содержащих массивы коллоидных квантовых точек CdS, CdSe/ZnS и CdZnSeS/ZnS. № 9
- Тихонов Р. Д., Поломошнов С. А., Горелов Д. В., Казаков Ю. В., Черемисинов А. А. Варьирование магнитных свойств пленок пермаллоя. № 9
- Тонолов В. Ю., Ермаков И. А. Пьезоэлектрические свойства и гидростатические параметры нового 2—0—2-комполита на основе кристалла релаксора-сегнетоэлектрика. № 11
- Федоров Ю. В., Михайлович С. В. Перспективы замены арсенидных МИС на нитридные. № 4
- Чуб Д. С., Фарберович О. В., Солдатов А. В. Динамика спинного кроссовера в молекулярных магнитах октаэтилпорфирина кобальта в терагерцевом импульсном магнитном поле. № 10
- Шерченков А. А., Козюхин С. А., Лазаренко П. И., Тимошенков С. П., Бабич А. В., Якубов А. О., Калугин В. В. Электрофизические свойства тонких пленок материалов фазовой памяти на основе халькогенидных полупроводников системы Ge—Sb—Te. № 9

ЭЛЕМЕНТЫ МНСТ

- Александров П. А., Бударгин В. В., Горемыкин А. М., Жук В. И., Литвинов В. Л. О построении дублированных логических элементов для повышения отказоустойчивости микросхем при облучении. № 4
- Александров П. А., Бударгин В. В., Жук В. И., Литвинов В. Л., Стельмак С. Е. Сравнительные оценки отказоустойчивости мажоритарно резервированных и покомпонентно дублированных микросхем при облучении. № 3
- Алексеева Л. Г., Иванов А. С., Лучинин В. В., Петров А. А., Романов А. А., Чигирев Д. А., Chikyow T., Nabatame T. Новая электронная компонентная база. Мемристор. № 5
- Афанасьев А. В., Ильин В. А., Лучинин В. В., Михайлов А. И., Решанов С. А., Schüner A. Отечественная карбидокремниевая электронная компонентная база — силовой SiC МДП-транзистор. № 5
- Афанасьев А. В., Ильин В. А., Решанов С. А., Романов А. А., Сергушичев К. А., Серков А. В., Чигирев Д. А. Карбидокремниевые фотодиоды УФ диапазона для экстремальных условий эксплуатации. № 5
- Афонин С. М. Статистические характеристики и упругие податливости многослойных пьезоактюаторов нано- и микроперемещений. № 1
- Багинский И. Л., Косцов Э. Г., Буханец Д. И. Оценка максимальной удельной мощности емкостных электростатических микрогенераторов. № 8
- Булярский С. В., Лакалин А. В., Абанин И. Е., Амеличев В. В., Светухин В. В. Напряжение холостого хода бета-батарей на основе кремниевых *p-i-n*-диодов. № 6
- Гриджин В. А., Зиновьев В. Б., Чебанов М. А. Микропрофилирование и оптимизация характеристик кремниевых сенсоров давления. № 7
- Дорофеев Р. Ю., Козлов Д. В., Смирнов И. П., Жуков А. А. Основные характеристики микросистемного вибрационного модулятора электрических полей космического назначения. № 12
- Кранунин Д. В. Малошумящие усилители диапазона 60 ГГц. Обзор мировых коммерческих разработок. № 12
- Кузнецов Е. В., Сивченко А. С., Кессаринский Л. Н. Оценка основных характеристик надежности и радиационной стойкости КМОП ИС с помощью тестовых структур в составе пластин. № 9

- Кутвицкий В. А., Маслов Л. П., Миронова Е. В., Борисова Е. Я., Несговорова Э. А., Муштанов А. В., Ходин М. А. Формирование сенсорного элемента для определения влажности воздуха на основе электропроводящего полимера. № 12
- Лагош А. В., Корляков А. В. Механизмы деградации ВЧ МЭМС-ключей. № 5
- Лобач О. В. Беспроводная система мониторинга тепловых потерь на основе МЭМС-сенсора теплового потока. № 7
- Лысенко И. Е., Ежова О. А. Исследование влияния параметров элементов подвесов на собственную частоту конструкции микромеханического сенсора линейных ускорений. № 6
- Мальцев П. П., Федоров Ю. В., Гнатюк Д. Л., Матвеев О. С., Путинцев Б. Г., Зуев А. В. Монолитная интегральная схема ГУН V-диапазона. № 10
- Мустафаев Г. А., Мустафаева Д. Г. Прогнозирование надежности пленочных преобразователей по изменению параметра — критерия годности. № 2
- Обухов И. А., Смирнова Е. А. Нанопровод как активный элемент генератора СВЧ излучения. № 8
- Парфенов Н. М. Аналитические исследования интегральных МЭМС-акселерометров. № 2
- Печерская Р. М., Волохов И. В., Гурин С. А., Абдуллин Ф. А. SiC в качестве изоляционного слоя чувствительного элемента тензометрического датчика давления для особо жестких условий эксплуатации. № 12
- Печерская Р. М., Соловьев В. А., Ракша С. В., Николаев К. О., Кондрашин В. И. Сенсибилизированные красителем солнечные элементы: современное состояние и перспективы развития. № 2
- Смолин В. К. Высокочастотная микроэлектроника на структурах с кремниевыми подложками. № 11
- Смолин В. К., Шоболов Е. Л. Вакуумная микроэлектроника — перспективный путь создания элементной компонентной базы для эксплуатации в экстремальных условиях. № 4
- Тимошенков В. П., Родионов Д. В., Хлыбов А. И., Мусаткин А. С., Вертянов Д. В. Исследования 3D СВЧ сборок на полиимидном шлейфе для систем в корпусе. № 10
- Уваров И. В., Наумов В. В., Королева О. М., Ваганова Е. И., Амиров И. И. Бистабильный МЭМС-переключатель с механизмом активного размыкания электродов. № 9
- Чесноков В. В., Чесноков Д. В., Райхерт В. А. Акустооптические тонкопленочные устройства на изгибных упругих волнах. № 2
- Шиколенко Ю. Л., Лапин Д. Г., Антонович А. Н. Исследование деградационных процессов в ячейках энергонезависимой памяти методикой контактной сканирующей емкостной микроскопии. № 2
- Шлемин Д. Л., Лебедев Ю. П., Лысь В. Д. Обзор опыта разработки субмикронных интегральных микросхем в ООО "СибИС". № 7

БИОЭЛЕКТРОНИКА

- Абрамов И. И. Перспективы использования нанoeлектроники, наноматериалов и нанотехнологий в исследовании и медицине мозга человека. № 1

ПРИМЕНЕНИЕ МНСТ

- Куцова Д. С., Богатиков Е. В., Шебанов А. Н., Смирнова К. Г., Глушков Г. И. Анализ состава сложной газовой смеси сенсором на основе цеолита. № 9

СИСТЕМЫ НА КРИСТАЛЛЕ

- Вишников А. В., Ерохин В. В., Иванова Е. М. Выбор IP-блока при разработке системы на кристалле. № 12

Адрес редакции журнала: 107076, Москва, Стромынский пер., 4. Телефон редакции журнала (499) 269-5510. E-mail: nmst@novtex.ru

Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Свидетельство о регистрации ПИ № 77-18289 от 06.09.04.

Технический редактор Т. А. Шацкая. Корректор Е. В. Комиссарова.

Сдано в набор 21.10.2016. Подписано в печать 22.11.2016. Формат 60×88 1/8. Заказ МС1216. Цена договорная. Оригинал-макет ООО «Авансес солюшнз». Отпечатано в ООО «Авансес солюшнз». 119071, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 19, стр. 1. Сайт: www.aov.ru